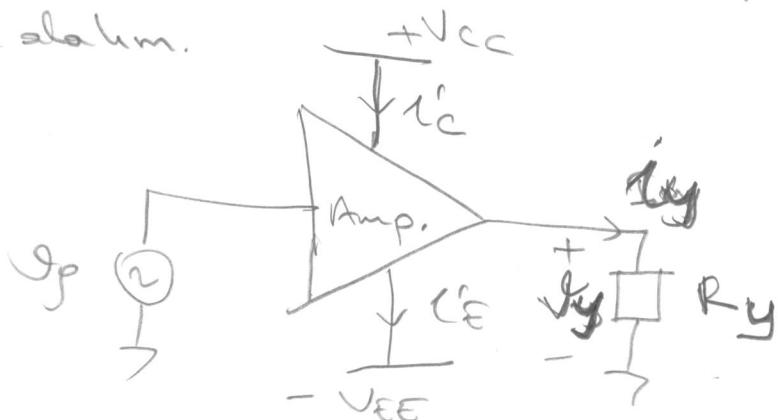


## GÜC KUVVETLENDİRİCİLERİ

Küçük işaret kuvvetlendiricilerden farklı olarak işaretin genliğiini yükseltmek yerine gücünü artırmayı sağlayan ~~kuvvetlendiricilerde~~ yükselterek devrelerdir. Amaç akısa mümkün olduğunca yüksek gücü aktarımı olduğundan verimlilik ( $\eta$ ) yük aktarılan gücün, beslene kaynakından gelen toplam gücü oraniyla hesaplanır.

<sup>varsız</sup> Beslene kaynakından gelen güç, yük aktarılan,  $\rightarrow$  en perhilme devresine verilen ve ısıya aktarılan güç bilesenlerine paylaştırılır. En genel güç ifadeleri 'önimetrik' beslenmiş bir kuvvetlendiriciyi ele alalım.



$$\begin{aligned} & i_{\text{Cort}} \rightarrow \text{ortalamalı } i_{\text{C}} \text{ akım} \\ & i_{\text{Eort}} \rightarrow \text{ortalamalı } i_{\text{E}} \text{ akım} \end{aligned}$$

Kaynakdan gelen toplam güç  $P_{\text{toplam}}$  olsun,

$$P_{\text{toplam}} = V_{\text{CC}} \cdot i_{\text{Cort.}} + V_{\text{EE}} \cdot i_{\text{Eort.}}$$

$$i_{\text{Cort.}} = \frac{1}{T} \int_0^T i_{\text{C.}} dt$$

$$i_{\text{Eort.}} = \frac{1}{T} \int_0^T i_{\text{E.}} dt$$

(2)

$I_{\text{Cort}}$  ve  $I_{\text{Eort}}$  akımları  $I_{\text{C}}$  ve  $I_{\text{E}}$  akımlarının DC değerleri olduğu için,  $\xrightarrow{\text{İzaret}}$  bozulması ihmal edilmiş bir senye formu;

$$I_{\text{Cort}} = I_{\text{Co}} \quad , \quad I_{\text{Eort}} = I_{\text{Eo}}$$

elde edilebilir.

Bu durumda;

$$P_{\text{toplam}} = V_{\text{cc}} \cdot I_{\text{Cort}} + V_{\text{EE}} \cdot I_{\text{Eot}}$$

denebilir.

Yukarıda aktarılan gibi tamamen ac bilesenli akım ve gerilimden oluşmaktadır. Bu durum sayiplandırıldığında ~~ekstra~~ <sup>yukarıda</sup> pöntleek ac izaretinin simetrik bir sinus dalgası etkileyen ortalaması değerini <sup>ekstra</sup>  $V_{\text{y}}$ 'yi DC değerini sıfır'a eşittir. Bu nedenle yukarıda işaretlenen gibi RMS olarak ifade edilir.

$$P_{\text{yRMS}} = \sqrt{V_{\text{yRMS}} \cdot I_{\text{yRMS}}}$$

$$V_{\text{y}} = V_{\text{ymax}} \cdot \sin \omega t$$

$$V_{\text{yRMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_{\text{ymax}}^2 \cdot \sin^2 \omega t \, dt}$$

$$I_{\text{y}} = I_{\text{ymax}} \cdot \sin \omega t$$

$$V_{\text{yRMS}} = \frac{V_{\text{ymax}}}{\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{yRMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_{\text{ymax}}^2 \cdot \sin^2 \omega t \, dt}$$

$$I_{\text{yRMS}} = \frac{I_{\text{ymax}}}{\sqrt{2}}$$

$$P_{\text{Ymax}} = \frac{V_{\text{Ymax}}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{\text{Ymax}}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} V_{\text{Ymax}} I_{\text{Ymax}}$$

(3)

$$V_y = R_y \cdot I_y \Rightarrow I_{\text{Ymax}} = R_y \cdot I_{\text{Ymax}}$$

$$P_{\text{Ymax}} = \frac{1}{2} \frac{V_{\text{Ymax}}^2}{R_y} = \frac{1}{2} I_{\text{Ymax}}^2 \cdot R_y$$

verimlilik ( $\eta$ ) ise;

$$\eta = \frac{P_{\text{Ymax}}}{P_{\text{Total}}} \quad \text{veya} \quad \% \eta = \frac{P_{\text{Ymax}}}{P_{\text{Total}}} * 100 \%$$

olarak hesaplanır.

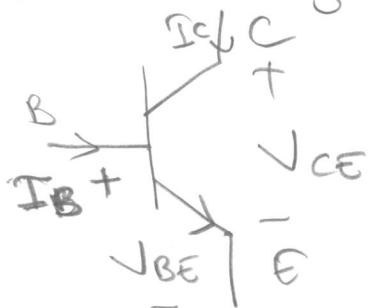
### Güç transistörleri:

Küçük işaret transistörlerine göre genelde ~~genellikle~~ yanıtla  
alanlı, farklı geometrili ve <sup>katlı</sup> kontraryonlu  
cihazların Güç BJT'leri:  
küllanılan 2N2222 BJT ile güç kuvvetlendirme  
maksatlı kullanılan 2N3055 BJT'yi karşılaştırı  
rsa:

<u>Parametre</u>	<u>2N2222</u>	<u>2N3055</u>
$V_{\text{CE(max)}} \text{ V}$	40	60
$I_C(\text{max}) \text{ A}$	0,8	15
$P_D(\text{max}) \text{ W}$	1,2	115
$\beta$	35-100	5-20
$f_T \text{ (MHz)}$	300	0,8

(4)

BJT' de güç tüketimi:



Aritik güç tüketimi:

$$P_d = V_{CE} \cdot I_c + V_{BE} \cdot I_B$$

gök kavisik  
kullan edilebilir.

$$P_d \approx V_{CE} \cdot I_c$$

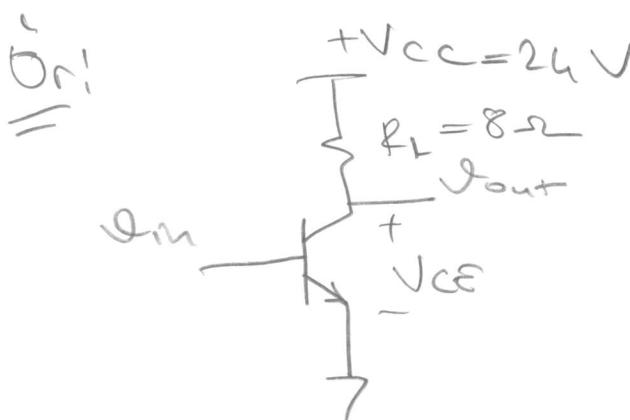
$$P_d \text{ort} = \frac{1}{T} \int_0^T V_{CE} \cdot I_c \cdot dt$$

ortalama  
güç

BJT' nin ortalama gücü belirli bir deşenin  
altında tutulmaktadır. Aksi halde ıshar fazla isnip  
yayar.

Eğer kollektör akımı ve kollektör-emiter  
gerilimini DC boyutları kullanılarak bulursak,  
transistördeki maksimum gücü;

$$P_T = V_{CE} \cdot I_c \text{ olur.}$$



Bu dencede kullanılabilecek  
BJT' un gerilim,  
akım ve güç  
sinirlarını hesaplayın

$$V_{CC} - R_L \cdot I_c - V_{CE} = 0 \quad \text{denklemini den}$$

$$V_{CE}=0 \Rightarrow I_{C(\max)} = \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{24}{8} = 3A$$

(5)

$$I_c=0 \Rightarrow V_{CE(\max)} = V_{CC} = 24V$$

transistörün güz tüketimi:

$$P_T = V_{CE} \cdot I_c = (V_{CC} - I_c \cdot R_L) I_c$$

$$P_T = V_{CC} \cdot I_c - I_c^2 \cdot R_L \quad \text{olar.}$$

maksimum güz  $\frac{\partial P_T}{\partial I_c} = 0$  noktasından

$$\frac{\partial P_T}{\partial I_c} = V_{CC} - 2 I_c \cdot R_L = 0$$

$$I_c = \frac{V_{CC}}{2R_L} = \frac{24}{2 \cdot 8} = 1,5 A$$

bu naktada  $V_{CE}$  perlimi:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_c \cdot R_L = 24 - 1,5 \cdot 8 = 12V$$

$$P_T = V_{CE} \cdot I_c = 12 \cdot (1,5) = 18W \quad \text{olar.}$$

Güz MOSFET'leri:

Geniş sıcaklık dayanımıları, stabiliteleri, ikinci katlama olayı olmaması ve güz BJT'lerne göre daha düşük analitiklerle daha avantajlıdır.

Güz MOSFET'leri dikdörtgen (VMOS - vertical MOS) veya çift difüzyonlu (DMOS - double diffused MOS) prosesleriyle üretilir.

Güz MOSFET'lerinde drain-source arası dikdörtgen sepeç resistiviteye sahip olduğundan

(6)

Vardan

acılma direnci  $R_{DS(on)}$ , MOSFET'in  
güc tüketimi açısından önemli bir parametredir.  
 ~~$R_{DS(on)}$~~  direnci genellikle mili ohm'lar  
mertebesinde yer alır. Drain akımı ile artar,  
1-2 ohm'a kadar ulaşabilir.

Bir püç MOSFET'inin geçidi ~~basit lojik kapılar~~  
la sınırlı 10 A akım aktıtabilir. Ancak püç  
BJT'si için  $\beta=10$  ise, 10 A kollektör akımı  
aktırmak için 1 A baz akımı gerektir. Lojik  
bir devre için bu akımı genellikle veremey ve  
İkinci sınırı devreye ihtiyaç duyulur.

~~Püç ve püç transistörler~~

Ör: Aşağıdaki MOSFET devresi için  $I_{Dmax}=6A$   
 $V_{DSmax}=40V$  ve  $P_T=30 W$  'dır.

a)  $V_{DD}=24 V$  ise , b)  $V_{DD}=40 V$  ise

$R_L=?$  ,  ~~$V_{DSQ}=?$~~  ,  $P_Dmax=?$  ,  $I_{Dmax}=?$

a)  $V_{DD}=24 V$  ise  $V_{DSQ}=\frac{V_{DD}}{2}=12 V$

$$V_{DD} - I_{DQ} R_L - V_{DSQ} = 0 \quad P_T = V_{DSQ} \cdot I_{DQ}$$

~~$P_D = \frac{V_{DD} \cdot I_{DQ}}{2}$~~

~~$D_{DS} = \frac{V_{DD}^2}{2R_L}$~~

$$\sqrt{D_{DS}} \Rightarrow I_{Dmax} = \frac{\sqrt{D_{DS}}}{R_L} = \frac{24}{R_L} = 4 \Rightarrow R_L = 6 \Omega$$

$$P_{Dmax} = V_{DSQ} \cdot I_{DQ} = 12 \cdot \frac{12}{6} = 24 W$$

# Analizi detaylandırın:

(7)

$$V_{DD} = 24 \text{ V} \quad V_{DSQ} = \frac{V_{DD}}{2} = 12 \text{ V}$$

Bu <sup>→</sup> simetrik sehpası sabit olmak ideal periferi deşeridir. Bu da karsılık gelen akım

$$I_{DSQ} = \frac{I_{Dmax}}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ A olmalıdır.}$$

Eğer transistörün güç sınırı izin verirse bu akım okar. ( $P_{Dmax} \leq P_T$  olmalıdır.)

$$P_T = 30 \text{ W} \quad P_{Dmax} = V_{DSQ} \cdot I_{DSQ}$$

$$P_{Dmax} = 12 \cdot 2 = 24 \text{ W}$$

$P_{Dmax} \leq P_T$  oldugundan;

$$I_{DSQ} = 2 \text{ A} \quad I_{Dmax} = 4 \text{ A}$$

$$V_{DSQ} = 12 \text{ V} \quad P_{Dmax} = 24 \text{ W}$$

Yük hattı denklemleri;

$$V_{DD} - R_L \cdot I_D - V_{DS} = 0$$

$$R_L = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{I_D} \xrightarrow{\phi} I_{Dmax} = 4 \text{ A iken } V_{DS} = 0 \text{ V}$$

$$R_L = \frac{24}{4} = 6 \Omega \text{ olur.}$$

b)  $V_{DSQ} = \frac{V_{DD}}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ V.}$  <sup>bütün</sup>

~~$P_{DSQ}$~~   $I_{DSQ} = \frac{I_{Dmax}}{2} = 2 \text{ A olur.}$

$$P_T = 30 \text{ W} \quad P_{Dmax} = V_{DSQ} \cdot I_{DSQ} = 20 \cdot 2 = 40 \text{ W}$$

$P_T < P_{Dmax}$  oldugundan bu  $I_{DSQ}$  akımı okar.

O halde akarsi gerekten  $I_{DS}$  okunuşu:

(8)

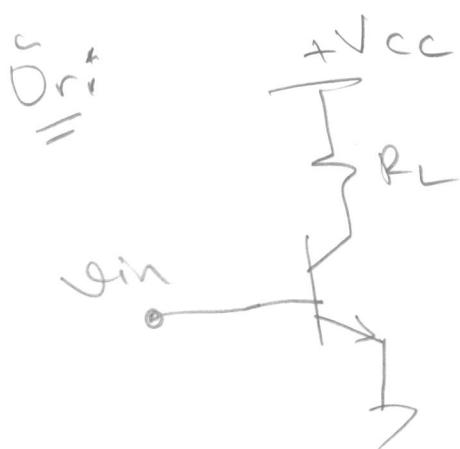
$$P_T = V_{DS} \cdot I_{DS} \Rightarrow 30 = 20 \cdot I_{DS}$$

$$I_{DS} = 1,5 \text{ A olur.}$$

$$I_{Dmax} = 2 I_{DS} = 3 \text{ A olur.}$$

$$P_{Dmax} = P_T = 30 \text{ W}$$

$$R_L = \frac{V_{DD}}{I_{Dmax}} = \frac{40}{3} = 13,33 \Omega$$



Yandaşı BJT püş transistör  
için  $I_{Cmax} = 5 \text{ A}$   $V_{CE(max)} = 30 \text{ V}$

$$P_T = 25 \text{ W tr.}$$

$$\text{a) } V_{CC} = 24 \text{ V} \quad \text{b) } V_{CC} = 12 \text{ V}$$

$$R_L, I_{Cmax}, P_{Dmax} = ?$$

a)  $V_{CC} = 24$  ian.  $V_{CEQ} = \frac{V_{CC}}{2} = 12 \text{ V}$  olur.

Akim  $I_{CQ} = \frac{I_{Cmax}}{2} = 2,5 \text{ A}$  kabul edilir.

$$P_Q = V_{CEQ} \cdot I_{CQ} = 12 \cdot 2,5 = 30 \text{ W}$$
 bulunur.

$P_Q > P_T$  olamayacağından;

$P_Q = P_T$  olur. Akım yeriden hesaplanır.

$$25 = 12 \cdot I_{CQ} \Rightarrow I_{CQ} = 2,085 \text{ A}$$

$$I_{Cmax} = 2 \cdot I_{CQ} = 4,17 \text{ A}$$

$$R_L = \frac{V_{CC}}{I_{Cmax}} = \frac{24}{4,17} = 5,76 \Omega$$

(9)

$$P_{D\max} = P_T = 25 \text{ W} \quad \text{oben.}$$

b)  $V_{CEQ} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ V} \quad \text{oben}$

$$I_{CEQ} = \frac{I_{Cmax}}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ A} \quad \text{oben,}$$

$$P_{D\max} = V_{CEQ} \cdot I_{CEQ} = 6 * 2,5 = 15 \text{ W} \quad \text{oben,}$$

$$P_{D\max} < P_T \quad \text{abgedreht}$$

$$I_{CEQ} = 2,5 \text{ A} \quad I_{Cmax} = 2 \cdot I_{CEQ} = 5 \text{ A} \quad \text{oben.}$$

$$R_L = \frac{V_{CC}}{I_{Cmax}} = \frac{12}{5} = 2,4 \Omega$$

$$P_{D\max} = 6 * 2,5 = 15 \text{ W}$$